⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭62-54229

@Int Cl.⁴		識別記号	厅内整理番号		∅公開	昭和62年(198	7)3月9日
G 02 F.	1/133 1/13	$\begin{array}{c} 1 \ 2 \ 5 \\ 1 \ 0 \ 1 \end{array}$	8205-2H 7448-2H					
-G 09 F	9/35		6810-5C	審查請求	未請求	発明の数	2	(全6頁)

❷発明の名称 液晶表示装置の作製方法

> 创特 頤 昭60-155837

@H 昭60(1985)7月15日

四発 明 老 川 峅 平 東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 株式会社半導体工 ネルギー研究所内 73発 阴 小 沼 利 光 東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 株式会社半導体エ ネルギー研究所内 @発 明 老 東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 浜 磁 次 株式会社半導体エ ネルギー研究所内 @発 明 渚 冏 颉 晃 東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 株式会社半導体工 ネルギー研究所内 厚木市長谷398番地

株式会社 半導体エネ

ルギー研究所

最終頁に続く

1.発明の名称

液晶表示装置の作製方法

2.特許請求の範囲

- 1. 電極を互いに有する一対の基板の被充塡面を 内側にして対向せしめ、前記被充塡面間に液 晶を充塡した液晶表示装置の作製方法におい て、前記基板の被充塡面間にスメクチック液 晶を充塡せしめると同時に、前記一対の基仮 の周辺部を封止せしめることを特徴とする液 晶表示装置の作製方法。
- 2. 特許請求の範囲第1項において、封止は長方 形または正方形の基板の少なくともコーナ部 に対して行うことを特徴とする液晶表示装置。 の作製方法。
- 3.電極を互いに有する一対の基板の被充版面を 内側にして対向せしめ、前記被充塡而間に液 晶を充塡した液晶炎示装置の作製方法におい て、前記基板の被充塡面間にスメクチック液 .晶を充塡せしめると同時に、前記一対の長方

形または正方形の悲板のコーナ部を封止せし める工程と、該工程の後、長方形または正方 形の基板の辺の部分に対し封止せしめること を特徴とする液晶表示装置の作製方法。

3.発明の詳細な説明

「発明の利用分野」

この発明は、液晶表示装置の作製方法に関する ものであって、スメクチック液晶(以下Sm液晶ま たは液晶という) 特に例えば強誘電性液晶 (以下 FLC という)を用いた表示パネルを設けることに より、マイクロコンピューク、ワードプロセッサ またはテレビ等の表示部の河膜化を図る液晶表示 装置の作製方法に関するものである。

「従来の技術」

一個体表示パネルは各終素を独立に制御する方式 が大面積用として有効である。このようなパネル として、従来は、二周波液晶例えばツウィスティ ック・ネマチック液晶(以下TN液晶という)を用 い、横方向400 紫子また縦方向200 紫子とする44 判サイズの単純マトリックス構成にマルチプレキ

(1)

シング駆動方式を用いた表示装置が知られている。

しかし、かかるTN液晶を作製せんとした場合、このTN液晶の粘度が低いため、一対のガラス悲板の間隙をあけて対抗せしめ、この一対のガラス悲板の周辺部に封止用シール剤をスペーサを混合して独布し、お互いを按着させる。この残けておく。この後この周辺が封止された一対の基板を真空容器内に保持し、全体を真空なで、この真空容器内をTN液晶でといる。この真空な器内を大気圧にする。この真空な器内を大気圧にすること、毛細管現象を利用して一対の基板により、毛細管現象を利用して一対の基板によってあった。

「発明が解決しようとする問題点」

しかしかかる方法は、TN液晶の如き室温で低粘度の液晶を基板間に充填する場合には優れている。 しかし、

(1) 粘度の高いスメクチック液晶例えばSmC*層を 用いるFLC に対してはきわめて作業がしづら

(3)

面上に液晶を設けた後、この液晶上に他方の基板 の被充填面を密接せしめ、さらに一対の基板を所 定の相互位置に配設せしめるものである。さらに この工程と同時工程として、周辺部特に正方形ま たは長方形の基板のコーナ部に封止用シールを行 わしめるいわゆるラミネート(薄層にする、薄層 にのばすの意)方式を用いることを基本とする。

加えて本発明においては、液晶材料としてスメクチック液晶、特に好ましくはスメクチック C ff (SmC*) を呈する強誘電性液晶を用いる。即ちセルの間隔を 4 μmまたはそれ以下の一般には0.5 ~3 μmとすることにより双安定状態を得ることができる。

即ち、かかる一方の基板の電板上の被充域而上の一点または複点に(等方性)液晶を流下、散布またはコートする。さらに一方または他方の基板のコーナ部に封止用樹脂を微量滴下する。この後、他方の基板をこの上に配設する。

さらにこれらを真空引きをし、その前後におい て加熱し、その一対の基板を互いに加圧して、そ LV

- (2) セルの電極間の間陸を4 μ以下好ましくは0.5 ~ 3 μの狭い間陸を用いることを前提とする FLC を用いる場合、充風にきわめて時間がか かってしまう。
- (3) FLC を大面積例えば A 4 版に対し充転せんと する場合、8~10時間もの長時間高温例えば 120 でで充填作業を必要とする。そのため、 周辺部の封止が劣化しやすい。またこの封止 材料が不純物として液晶内に混入しやすい。
- (4) 液晶の充壌に伴いセルギャップを決めている スペーサ (通称貝柱) が一方に偏りやすい。
- (5) 充版の際有効に用いられない液晶材料が全体 の90%近くになってしまい無駄が多い。
- 等の多くの欠点を有する。

本発明はかかる問題点を解くものである。

「問題を解決するための手段」

かかる問題を解決するため、本発明は、一対の 基板に対し液晶を充壌する前に一対の基板の同辺 部をシールするのではなく、一方の基板の被充壌

(4)

れぞれの基板の内側に設けられた被充壌而を 4 μ 以下の間隙にして互いにPLC と密接せしめ、加え て周辺部の少なくとも一郎を同時に封止せしめる。

さらにこの薄いPLC が充塡されラミネートされた基板の温度を降下させ、SmA を得、さらに双安定なSmC*を得る。するとらせん構造をとくことができる。この後、常温に保存した後、周辺部の辺の部分に対しシール用のプラスチック封止剤による封止を行う。

かかる本発明方法においてはこのコーナ部でお 互いの基板の接触面積を多くでき、互いに固く固 着させることができる。

また本発明でも残された問題点の使用温度範囲は、現在複数の異なったFLC を組合わせて(ブレンドして)0~50でにおいて使用が可能となっている。このため実用上はそれほど問題とならず、また階調に関してはカラーも8色までとするならば階調が不要であり、マイクロコンピュータ等のディスプレイとしては十分実用が可能であることが判明した。

(5)

「作用」

かくすることにより、

- (1) セルはスペーサを散布しその大きさにより最小の間談を決定するため、形成されるPLC の間談にばらつきがない。
- (2) 4 µ以下の間除(セル厚)の薄いセルであっても大面積(A4版相当)であっても短時間でラミネート作業を行うことができる。
- (3) 基板上に設けたPLC を100X有効利用することができる。
- (4) 粘度の高いPLC を用いても、そのラミネート および封止の作業に1時間以上を必要としない。
- (5) 一方の基板側にはアクティブ素子とそれに連結した電極を設けても、まったくアクティブ 素子を用いないパッシブ構造と同一工程でPLC のラミネートができる。

さらに、これらの特徴により本発明の液晶のラミネート(2つの基板の間陸を少しづつ狭くし、 その間に液晶を薄層化して介在させることを示す)

(7)

シェドウ処理(マスク)の形成、アクティブ紫子 の作製等を必要に応じて行うことは有効である。

また、基板は一般にはガラス基板例えばコーニング7059を使用する。しかし基板の一方または双方に可曲性の基板を用いることは有効である。そしてその可曲性基板として、化学強化がなされた0.3~0.6mm 厚のガラス基板、またはポリイミド、PAH.PEI 等の透光性耐熱性有機樹脂基板を用いることは有効である。

この基板上の電極上には配向処理層(非対称配向処理層)が設けられ、その上面を被充域面とした。そしてこの面上に、FLC、例えばS8(オクチル・オキシ・ペンジリデン・アミノ・メチル・ブチル・ベンジェイト)を設けた。これ以外でも、BOBANBC等のFLCまたは複数のブレンドを施したFLCを充填し得る。例えばここではS8とB7とのブレンドした被晶を用いた。

さらにこの一対の基板の一方の被充塡面上に液晶(2)を滴下させた。

さらに他方の被充塡面を下側に配向させた複数

方法を用い、加えて非線型案子(NE)と強誘電性液品(FLC)とを直列にして各画素を構成せしめる場合、A4版またはそれ以上の大面積のマトリックス化にそれぞれの画素間のクロストークを除去し駆動させることが初めて成就できた。

以下に実施例に従って木発明を説明する。 「実施例1」

第1図は本発明の液晶表示装置の作製工程を示す。

第1図(4) は2つの基板(1)、(1')を有する。この相対向する面(8)、(8')側にはそれぞれ電極を有している。またカラー表示をするには、その一方の側の電極と基板との間または電極と充填される破晶との間にカラーフィルタが設けられている。さらにこの電極の上面には公知の非対称配向処理がなされている。

これらの図面では、簡単にするため図示することを省略して単に基板として表記している。しかし一対の基板の相対向する側にこれらの電極、フィルタ、配向処理、ブラックマトリックス化する

(8)

の周辺部特にコーナ部にエポキシ系の封止の樹脂 (19)、(19')を微量に滴下した。これは熱硬化性樹脂を用いた。

かかる被晶が設けられた一対の基仮を第1図(B)に示すごとき真空容器(100)に對入した。この真空容器(100)に第1の空間を有し、資側(10)に第2の空間(5)を有する。第1の空間(4)内にはヒータ(3)が設けられている。このとし、全額(4)内にはヒータ(3)が設けられている。この基板を室温~150 セ内の所定の温度、例えば120 セに最初を変温~150 セ内の所定の温度、例えば120 セに動物でせた。すると既に基板(1)上の被充地面に設けられた液晶(3)が加熱され被充地面にがかる。この液晶を液下して設ける前または後に所定の間隔をおいて基板上にスペーサを配設させた。このスペーサはまったく用いない方式をとってもよい。

さらにこの上方に対向する他方の基板(1')を 1 ~10 mm 難問してまたはかるくお互いを部分的に接せしめて配置させた。

この後、この第2の空間(5) を有する蓋側容器(10') を0リングにより容器(10)側に合わせ込んだ。この第2の空間の下側には、第1の空間と第2の空間とがお互いに弾力性を有する層(以下簡単のためシリコンラバー(6) という)で遮蔽されている。そして第2の空間と第1の空間の圧力において、第1の空間の圧力が正圧の場合は下側を膨張し、逆の負圧の場合は上側に引っ張られるようになっている。このラバーは少なくとも150 での温度に耐えることができる材料であれば、シリコンラバーにかぎらない。

これらをOリングにより互いに合わせ込み、(11). (11') より同時に真空引きをした。即ち、この2つの出口は、バルブ(12). (12')を経て真空ポンプ(14)に連結されている。そしてこのバルブ(12). (12') をともに聞、バルブ(13). (13')をともに閉として、第1および第2の空間(4), (5) をともに真空空間とした。

さらに第1図(C) に示す如く、この上面に離間 している他方の基板を静宏に配設した。

(11)

この時一方の液晶または他方の封止材が互いに 混合したり、また所定の位置以上に他方により広 がらないように、1~3μの繊維よりなるパリア (18)、(18')を配設しておくと有効である。またこ のパリアはコーナ部のみでなく周辺全領域にわた って設けてもよい。

さらにその一対の基板の電極側の間陸は4μ以下例えば2μの均一な厚さとすることができる。 そしてこの厚さはスペーサが2μの大きさのもの を予め配設しておくと2μとなり、1μのスペー サを散布させておく時には1μとすることができ る。

もちろんスペーサをまったく用いず、この圧力 と加熱している温度とのみを精密に関節して所定 の厚さにラミネートさせることも可能である。

その結果、液晶の余分のものは周辺部に移動する。しかしこの外周辺をシリコンラバーが覆っているため、またはバリア(18)、(18')が堤防の如くにブロッキングしているため、これが基板の一部の外側周辺より外側に液晶があよれることを実質

すると液晶(3) は上下の被充塡面に互いに充塡される。加えてコーナ部の封止材(19)、(19')が加熱されている蒸板側に接触し温度を上昇させる。そして引き続き、他方の第2の空間(5) を真空状態より第1の空間(4) に比べて正圧となるように徐々にバルブ(13') より大気または窒素をリークし大気圧にさせた。

すると第1図(C) に示す如く、シリコンラバー (6) は下側に膨張し、対向する他方の基板(1')を一方の基板(1) の側に押しつける。そして大気圧においては1kg/cm² の圧力を加えることができる。また窒素によりさらに加圧する場合は1気圧以上の2~5kg/cm²の圧力とすることも可能である。

かくして一対の悲板の全表面に均一な圧力を加えることができ、この圧力により液晶は一点また は複数点に点状に設けられていたが、複方向に基 板(1) の表面にそって広がり、ラミネートされる。

加えて封止材もそのコーナ部で広がり、1~15 mm の而積にてそれぞれの基板を互いに密接せし めた。

(12)

的に防ぐことができる。またすべての外周辺より 液晶があふれたり、また所望の領域全体を覆うことなく足りなくなったりすることは、初期の液品 の供給量を特密にすることにより防ぐことができ

2 つの基板のおたがいの X 方向 Y 方向の重ね合わせは密着させる基板(1),(1')及び液晶(3) が加熱されている低粘度状態の時に移動させ再配設させることができる。

この後、第1図(C) でヒータを徐々に室温に降下した。さらに第1の空間(5) をも大気圧とし真空容器(100) の猹(10') を取り外した。一対の基板間に液晶をラミネートさせたセルを容器より取り出し第1図(D) を作る。

この図はコーナ部を示し、封止材が2つの基板の間にも介在し、それぞれを密着させている。

かくして第1図(D) に示す如く、2つの対向する基板(1).(1')は液晶(3) を互いに実質的に重ね合わせた状態にする。

第1図(E) は周辺部の辺の部分にその後の工程

(13)

において外側より封止用シール剤(9)(一般にはプ ラスチック材料) を盤布し、お互いの基板を固着 させる.

もちろん第1図(A) において、封止材(19).(19') は正方形または長方形の基板のコーナ部のみでは なく辺となる部分に対しても同時に滴下し、外周 辺のすべてを液晶のラミネイトと同時に封止をさ せてもよい。

かくして、本発明のスメクチック液晶の如く、 高い粘度を有する液晶、特にPLCでの基板間での充 塡ラミネート方法を確立することができた。

かくすることにより、A4版(20cm ×30cmの面積) 1 枚で使用する液晶は0.2cc で十分であり、3000 円/6と金より高価な液晶をきわめて有効に用いる ことができる。

1回の液晶の充填作業を約1時間の短時間で行 うことができる.

大面積になっても、作業時間は長くならないと いう特徴を有する。

(15)

を設け、反射型とする場合は、その入射光側の電 極を透光性とし、他方を反射型電極とする。そし てFLC のチルト角を約45度とすることにより、1 枚のフィルタを入射光側の基板上に配設して実施 することができる。

他方、 2 枚のフィルタを用いて透過型または反 射型とする場合は、2枚の偏光板をそれぞれの基 板の外側に配向させ、FLC のチルト角を約22.5度 とすることにより成就させ得る。 透光型において はバックライトをEL(エレクトロ・ルミネッセン ス) 蛍光灯または自然光により照射し、透光する 光の量を制御することによりディスプレイとする ことができる。

カラー化する場合は他方の対向基板側(人間の 目で見える側)の電板の上側または下側にカラー フィルタを設ければよい。

- さらに本発明においては、基板上に非線型宏子 を配設し、その上方に電極を設けたものを基板と して取扱い、アクティブ衆子型とすることができ る。かかる場合、この非線型素子としてNIN 型等

即ち、従来より公知のTN液晶の充填作業におい ては、この液晶に応力が加わらないようにするこ とが主である。そのため、周辺部のシール預はお たがいの基板に外郎より加わり得る圧力が液晶そ れ自体に加わらないよう互いの力を支えている。

しかしスメクチック液晶では、この力が液晶そ れ自体に加わってもその粘度が大きく、差し支え ないことを本発明人は見出した。そしてこの特性 を利用することにより従来とはまったく異なる本 発明の如き作製方法を可能にすることができた。

以上の本発明の液晶の充填方法において、被充 填面を構成する配向処理圏を非対称配向処理とし、 一方をラピング処理をし、他方を非ラピング処理。 とする。この時、本発明の如くラミネイトした後、 この基板をラピングを施した面にそって高温状態 等で微動(1μ以上の1~10′μm)シフトさせ、 ストレスを液晶に加え配向せしめることは有効で ある。

以上に述べた本発明の液晶表示装置において、 この基仮の一方または双方の基板の外側に偏光板

(16)

の複合ダイオード構造を有するSCLAD(空間電荷制 限電流型アモルファス半導体装置)、絶縁ゲイト 型電界効果半導体装置を用いることが可能である。

本発明の液晶表示装置において、ライトベンを 用いたフォトセンサをドット状に作ることにより 表示とその読み取りとを行うことができる。

本発明の第1図の作製工程は100 ×100(カラー においては100 ×300)のマトリックス構成とした。

しかしこのドット数は640 ×400(カラーの場合 は1920×400).720×400 その他の排成をも有し得

5.図面の簡単な説明

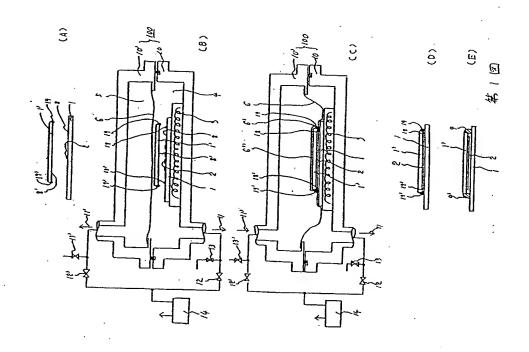
第1図は本発明の液晶表示装置の作製方法を示 す。

特許出願人

株式会社半導体エネルギー研究所 化麦老

山崎舜

(17)



第1〕	頁の	売き	•					
@発	明	者	小	柳	かお	る	東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号	株式会社半導体工
@発	明	者	今	任	慎	=	ネルギー研究所内 東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号	株式会社半導体ェ
@発	明	者	山	П	利	治	ネルギー研究所内 東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号	株式会社半導体エ
· @発	明	者	坂	E E	光	範.	ネルギー研究所内 東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号	株式会社半導体エ
@発	明	者	犬	島		·喬	ネルギー研究所内 東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 ネルギー研究所内	株式会社半導体エ